

**Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub> doped CeO<sub>2</sub>의 소결특성에 미치는 첨가제의 효과  
(Effects of Additives on Sintering Behavior of Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Doped CeO<sub>2</sub>)**

경성대학교 재료공학과  
최광훈, 이주신

고체전해질체는 고온에서의 이온전도성 물질로서 아주 우수한 특성을 갖고 있기 때문에 최근 많은 연구가 이루어지고 있다. 특히 연료전지 분야에 있어서는 Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 안정화 ZrO<sub>2</sub> 이외의 다른 물질을 찾고자 하는 노력이 많이 이루어지고 있다. 이에 전기전도특성이 ZrO<sub>2</sub>계보다 뛰어난 CeO<sub>2</sub>계가 주목을 받고 있다.

그러나 CeO<sub>2</sub>계는 1600°C 이상의 높은 소결온도를 필요로 한다. 따라서 소결온도를 낮추기 위해서는 균일하고 미세한 분말을 출발원료로 사용하거나, 소결조제를 첨가시키는 방법들이 도입되어야 한다. 한편, 균일하고 미세한 CeO<sub>2</sub>계 분말을 제조하는 것에 관한 연구보고는 많이 이루어져 왔지만, 소결조제를 첨가시켜 CeO<sub>2</sub>계의 소결성을 향상시키는 것에 관한 연구보고는 별로 이루어진게 없다. 특히 본 연구자들이 아는 한 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 첨가에 관한 보고는 전혀 이루어진게 없으며, Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 첨가에 관한 보고는 Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub> doped CeO<sub>2</sub>계에 대해 한 편의 보고가 있을 뿐이다.

이에 본 실험에서는 산소이온전도체 Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub> doped CeO<sub>2</sub>에 대한 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>와 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 첨가효과를 알아보기 위해 출발원료분말을 (Ce<sub>0.8</sub>Gd<sub>0.2</sub>O<sub>1.9</sub>)<sub>1-x</sub>(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>x</sub>, (x = 0 ~ 0.05), (Ce<sub>0.8</sub>Gd<sub>0.2</sub>O<sub>1.9</sub>)<sub>1-x</sub>(Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>x</sub>, (x = 0 ~ 0.1)와 같은 조성이 되도록 각각 공침법으로 합성하고 1400°C에서 5시간동안 소결시켜, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>와 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 첨가에 따른 소결특성을 살펴보았다.

소결밀도 측정에 의한 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>와 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>첨가에 따른 소결밀도의 변화, SEM 및 EDAX 측정에 의한 grain size 변화 및 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>와 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 존재상태확인, 그리고 XRD 측정에 의한 격자상수값의 변화 등을 통하여 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>와 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 첨가량에 따른 소결특성을 각각 조사하였다.